

2009年 4月1日 13:30~17:40

1p-D- /0

- | | | |
|----------------|--|--|
| 1 | はじめに Si系およびC系ナノ構造と励起プロセスについて (10分) | 筑波大電子・物理工 °村上浩一 |
| 2 | 低エネルギー照射によるカーボンナノチューブの構造と特性の改変 (30分) | NTT物性基礎研 °鈴木 哲, 小林慶裕 |
| 3 | 単層カーボンナノチューブにおける電子励起による欠陥生成(30分) | 東大工 °目良 裕, 前田康二 |
| 4 | 高輝度光によるナノカーボン材料の構造変化：時間依存第一原理計算(30分) | NECナノエレ研 °宮本良之 |
| 休憩 15:10~15:30 | | |
| 5 | 電子励起状態を介した量子ドットへのトンネル現象の変調 (30分) | 筑波大物理 ¹ , 東北大学際センター ² , 広島大先端研 ³ °野村晋太郎 ¹ , 櫻井蓉子 ¹ , 高田幸宏 ¹ , 白石賢二 ¹ , 村口正和 ² , 遠藤哲郎 ² , 池田弥央 ³ , 牧原克典 ³ , 宮崎誠一 ³ |
| 6 | トップダウンSiナノワイヤFETの作製法とその電気的特性のサーベイ (30分) | 東工大フロンティア研 ¹ , 東工大総理工 ² , 早大ナノテクノロジー研 ³ °岩井 洋 ¹ , 山田啓作 ³ , 大毛利健治 ³ , 筒井一生 ² , 角嶋邦之 ² , Parhat Ahmet ¹ , 佐藤創志 ¹ , 上村英之 ¹ , 新井英朗 ¹ |
| 7 | ボトムアップ手法：レーザーアブレーションによるSiナノワイヤの作製と不純物ドーピング (30分) | 物材機構 ¹ , JSTさきがけ ² , 筑波大電子・物理工 ³ °深田直樹 ^{1,2} , 関口隆史 ¹ , 瀬岡雅典 ³ , 齋藤直之 ³ , 村上浩一 ³ |
| 8 | ボトムアップ手法：Siナノワイヤ形成の構造・電気伝導・機械的強度その場観察 (30分) | 筑波大 °木塚徳志 |
| 9 | おわりに (10分) | 和歌山大シス工 °篠塚雄三 |